

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7029068号
(P7029068)

(45)発行日 令和4年3月3日(2022.3.3)

(24)登録日 令和4年2月22日(2022.2.22)

(51)国際特許分類	F I
C 2 3 G 5/00 (2006.01)	C 2 3 G 5/00
C 0 1 G 41/04 (2006.01)	C 0 1 G 41/04
C 2 3 F 15/00 (2006.01)	C 2 3 F 15/00

請求項の数 5 (全11頁)

(21)出願番号	特願2018-152165(P2018-152165)	(73)特許権者	000002200
(22)出願日	平成30年8月13日(2018.8.13)		セントラル硝子株式会社
(65)公開番号	特開2019-44264(P2019-44264A)		山口県宇部市大字沖宇部5253番地
(43)公開日	平成31年3月22日(2019.3.22)	(72)発明者	長友 真聖
審査請求日	令和3年5月26日(2021.5.26)		山口県宇部市大字沖宇部5253番地
(31)優先権主張番号	特願2017-163938(P2017-163938)		セントラル硝子株式会社化学研究所内
(32)優先日	平成29年8月29日(2017.8.29)	(72)発明者	八尾 章史
(33)優先権主張国・地域又は機関	日本国(JP)		山口県宇部市大字沖宇部5253番地
			セントラル硝子株式会社化学研究所内
		(72)発明者	北 拓也
			山口県宇部市大字沖宇部5253番地
			セントラル硝子株式会社化学研究所内
		(72)発明者	上島 修平
			山口県宇部市大字沖宇部5253番地
			セントラル硝子株式会社化学研究所内
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 タングステン酸化物の処理方法及び六フッ化タングステンの製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式 WO_x ($0 < x < 3$) で表されるタングステン酸化物を、温度 0 以上 500 未満で六フッ化タングステンと接触させて、化学反応によって一般式 $WO_y F_{6-2y}$ ($0 < y < 3$) で表されるタングステン酸フッ化物へ変換することを特徴とするタングステン酸化物の処理方法。

【請求項2】

前記温度が 80 以上 500 未満であることを特徴とする請求項1に記載のタングステン酸化物の処理方法。

【請求項3】

前記タングステン酸化物が、金属タングステンの自然酸化膜であることを特徴とする請求項1に記載のタングステン酸化物の処理方法。

【請求項4】

前記タングステン酸化物が、金属タングステンを含む膜の上に形成されたタングステン酸化物膜であることを特徴とする請求項1に記載のタングステン酸化物の処理方法。

【請求項5】

金属タングステンの自然酸化膜を、請求項1に記載のタングステン酸化物の処理方法により除去する工程と、

自然酸化膜を除去した前記金属タングステンにフッ素ガスまたは三フッ化窒素ガスを供給し、化学反応によって六フッ化タングステンを得る工程と、

を有することを特徴とする六フッ化タンゲステンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、タンゲステン酸化物を六フッ化タンゲステンと化学反応させて、タンゲステン酸フッ化物へ変換させる処理方法などに関する。

【背景技術】

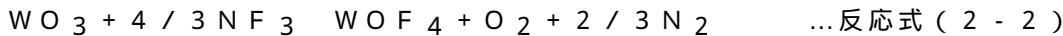
【0002】

金属タンゲステンおよびタンゲステン化合物を化学気相蒸着する際の前駆体として、六フッ化タンゲステンが知られている。これら前駆体の工業的な製造方法として、反応式(1-1)～(1-2)に示すように、金属タンゲステンとフッ素又は三フッ化窒素を接触させる方法が知られている。



【0003】

六フッ化タンゲステンの工業的な製造方法では、金属タンゲステンが使用されているが、大気に一度でも暴露された金属タンゲステンは表面酸化物で覆われている。この酸化物は、反応式(2-1)、(2-2)、(3-1)、(3-2)に示すように、F₂及びNF₃によってタンゲステン酸フッ化物及び六フッ化タンゲステンに転化される。しかし、これらの転化反応は、金属タンゲステンとF₂、及びNF₃との反応(反応式(1-1)、(1-2))よりも、見掛けの反応速度が遅いため、反応初期ではF₂とNF₃の転化率が低下する。



【0004】

そこで、転化率を向上させるために、金属タンゲステンの表面酸化物を除去することが求められる。

【0005】

金属タンゲステンの表面酸化物を除去するための考えられる一つ目の方法は、酸化物を還元させる方法であり、還元剤が水素ガスの場合、温度800K以上でタンゲステン酸化物は還元されて金属タンゲステンに変換されることが報告されている(反応式(4)参照)。

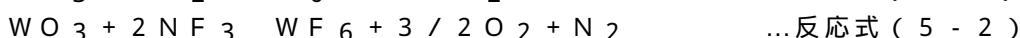
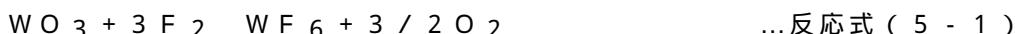


【0006】

二つ目の方法として、排気系内に堆積したタンゲステン酸化物とF₂またはフッ素含有ハロゲン間化合物(C₁F、C₁F₃、C₁F₅、BrF、BrF₃、BrF₅、IF₃、IF₅、IF₇等)とを接触させ、タンゲステン酸化物を蒸気圧の高い化合物に変換して除去する方法が開示されている(特許文献1参照)。

【0007】

フッ化ナトリウムを成型助剤として成型したタンゲステン酸化物と、フッ素又は三フッ化窒素を400程度で反応させ、六フッ化タンゲステンを得る方法が開示されている(特許文献2、3参照)。この方法から、三つ目の方法として、酸化物にF₂とNF₃を接触させ、六フッ化タンゲステンに変換して除去できることが予想される(反応式(5-1)、(5-2)参照)。



【0008】

四つ目の方法として、アルカリ水溶液(水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど)を酸化物に接触させて、タンゲステン酸塩に変換させることで酸化物を除去する方法が考えられ

10

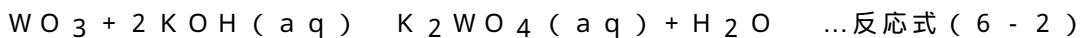
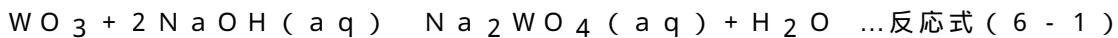
20

30

40

50

る（反応式（6-1）、（6-2）参照）。



【0009】

表1にWF₆、WOF₄、WO₃の1気圧での沸点と融点を示す。

【0010】

【表1】

	沸点	融点
WF ₆	17°C	2°C
WOF ₄	187°C	106°C
WO ₃	1800°C	1400°C

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0011】

【文献】特開平9-249975号公報

20

特開平1-234302号公報

特開平1-234304号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

しかしながら、タンゲステン酸化物を金属タンゲステンに還元するために水素ガスを利用する前記反応式（4）の方法を、工業的規模の製造を行う装置に適用する場合、可燃性ガスの水素を利用するため、支燃性ガスである六フッ化タンゲステン、フッ素、及び三フッ化窒素との接触で爆発的に反応するおそれがあり危険を伴う。また、還元させる際の温度が500以上と高く、さらに、還元により生じた水分を除去する必要があるため、適用することは難しい。

30

【0013】

また、特許文献1に記載の方法は、ハロゲン間化合物に含まれる塩素、臭素、ヨウ素が六フッ化タンゲステンに不純物として混入するおそれがあるため、適用することが難しい。また、ハロゲン間化合物の反応性が高いため、酸化物だけでなく、下地層、例えば金属タンゲステンやウエハ基板など、とも反応するため、適用することが難しい。

【0014】

特許文献2、3による酸化膜の除去方法（前記反応式（5-1）、（5-2））については、生成する酸素が金属タンゲステンと反応して再び酸化物を形成するため、除去するために時間を要する。また、フッ素と三フッ化窒素は反応性が高いため、酸化物だけでなく、下地層のタンゲステンとも前記の反応式（1-1）、（1-2）のとおり優先的に且つ局所的に反応するため、金属タンゲステンの酸化物を均一且つ選択的に除去させることが難しい。

40

【0015】

アルカリ水溶液による酸化膜の湿式除去方法は、タンゲステン酸化物を効率良く除去できるが、水分を除去するのに乾燥させる際に再度酸化膜が形成されるため、適用することが難しい。

【0016】

本発明の課題は、反応温度が500未満で、かつ反応によって酸素及び水を生成させることなく、金属タンゲステンに対して選択的にタンゲステン酸化物を蒸気圧の高い物質へ

50

変換する方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0017】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、六フッ化タンゲステンは金属タンゲステンとほとんど反応しないが、タンゲステン酸化物を六フッ化タンゲステンに接触させると、反応式(7)に示す反応などにより、蒸気圧の高いタンゲステン酸フッ化物に転化され、タンゲステン酸化物を除去できることに着目し、本発明にいたった。



...反応式(7)

【発明の効果】

【0018】

本発明によれば、反応温度が500℃未満で、かつ反応によって酸素及び水を生成させることなく、金属タンゲステンに対して選択的にタンゲステン酸化物を蒸気圧の高い物質へ変換することができる。

【図面の簡単な説明】

【0019】

【図1】本発明の一実施形態に係る自然酸化膜の処理装置10を示す図である。

【図2】本発明の他の実施形態に係るタンゲステン酸化物膜の処理装置20を示す図である。

【図3】実施例・比較例における処理装置30を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0020】

本発明のタンゲステン酸化物の処理方法などの実施形態を、詳細に説明する。しかしながら、本発明は、以下に示す実施の形態に限定されるものではない。

【0021】

本発明のタンゲステン酸化物の処理方法は、一般式 WO_x ($0 < x < 3$)で表されるタンゲステン酸化物を六フッ化タンゲステンと温度0℃以上500℃未満で接触させて、化学反応によって、蒸気圧の高いタンゲステン酸フッ化物 WO_yF_{6-2y} ($0 < y < 3$)へ変換することを特徴とする。タンゲステン酸化物としては、例えば、 WO_3 、 WO_2 、 W_2O_3 からなる群から選ばれる物質を挙げることができ、タンゲステン酸フッ化物としては、例えば、 WO_4 、 WO_2F_2 からなる群から選ばれる物質を挙げることができる。六フッ化タンゲステンは、金属タンゲステンとほとんど反応せず、金属タンゲステンに対して選択的にタンゲステン酸化物と反応する。

【0022】

例えば、タンゲステン酸化物 WO_3 (融点1400℃、沸点1800℃)を六フッ化タンゲステン WF_6 と接触させると、前述の反応式(7)に示すように、化学反�応によって酸素を発生させることなく、タンゲステン酸フッ化物 WO_4 (融点106℃、沸点187℃)に変換することができる。 WO_4 は、 WO_3 よりも遙かに蒸気圧が高いため、80℃程度で容易に除去される。

【0023】

<温度>

タンゲステン酸化物と六フッ化タンゲステンが接触するときの温度として、0℃以上500℃未満であることが好ましく、80℃以上350℃以下であることがより好ましい。0℃未満では六フッ化タンゲステンが固化して、タンゲステン酸化物との反応が遅くなるため好ましくない。80℃未満ではタンゲステン酸化物と六フッ化タンゲステンは反応し、タンゲステン酸フッ化物 WO_4 が生成するが、生成物を気化させるための後処理が別途必要となる。後処理の方法は特に限定されないが、例えば、加熱、脱気、不活性ガスによるバージなどがある。不活性ガスとしては、金属タンゲステン、六フッ化タンゲステンと反応しない材料、例えば、窒素、ヘリウム、アルゴン、四フッ化炭素などを使用することができる。350℃を超える場合、本発明を実施するための容器の材質が制限されるため好ましくない。500℃以上の場合、本発明を実施するための容器の材質が更に制限され

10

20

30

40

50

るため好ましくない。特に、180以上であると、短時間でタンゲステン酸化物をタンゲステン酸フッ化物に変換することができる点で好ましい。

【0024】

<六フッ化タンゲステンとタンゲステン酸化物の接触方法>

タンゲステン酸化物と接触させる際の六フッ化タンゲステンの状態として、液体及び気体の状態を選択することができるが、六フッ化タンゲステンは融点2、沸点17であることから、取扱いやすい気体の状態が好ましい。

【0025】

タンゲステン酸化物と六フッ化タンゲステンを接触させる方法として、バッチ式、連続式の何れでもよい。六フッ化タンゲステンは静止(固定)していてもよく、移動(流動)していてもよい。接触されるタンゲステン酸化物についても同様である。

10

【0026】

<六フッ化タンゲステンの供給方法>

タンゲステン酸化物と接触させる際の六フッ化タンゲステンの供給方法として、タンゲステン酸化物に接触するガス中に六フッ化タンゲステンが含まれていればよく、六フッ化タンゲステンを直接供給する方法だけに限定されず、間接的に供給する方法でもよい。間接的に供給する方法として、例えば、原料としてフッ素、三フッ化窒素、及び金属タンゲステンを使用して反応式(1-1)、(1-2)によって生成した六フッ化タンゲステンを接触させてもよい。但し、未反応のフッ素、三フッ化窒素が処理対象となるタンゲステン酸化物の下地層と反応するおそれがあるため、フッ素、三フッ化窒素の転化率は99%以上が好ましい。

20

【0027】

<六フッ化タンゲステンとタンゲステン酸化物を接触させる際の雰囲気>

タンゲステン酸化物と六フッ化タンゲステンを接触させるとき、容器及び装置の雰囲気には水分及び酸素が含まれると、タンゲステン酸化物の下地層が酸化されるおそれがあるため、水分及び酸素が極力含まれない、例えば、水分と酸素の濃度が100体積ppm未満の雰囲気が好ましい。容器及び装置の雰囲気として、不活性ガスを挙げることができる。

【0028】

<圧力>

30

六フッ化タンゲステンとタンゲステン酸化物を接触させる際の圧力が絶対圧で0.01kPa以上300kPa以下であることが好ましく、絶対圧で0.01kPa以上100kPa以下であることがより好ましい。絶対圧0.01kPa未満では、圧力を保持するための設備の負荷が大きくなるため、好ましくない。300kPa以上では、六フッ化タンゲステンが液化する可能性がある上に、装置から六フッ化タンゲステンが漏えいするおそれがあるため好ましくない。

【0029】

(金属タンゲステンの自然酸化膜のクリーニング方法)

本発明のタンゲステン酸化物の処理方法を用いたクリーニング方法の一実施形態を、図1を用いて説明する。図1に示す自然酸化膜の処理装置10は、自然酸化膜を有する金属タンゲステン11が充填された容器12、金属タンゲステン供給器13、六フッ化タンゲステンガス供給器14、不活性ガス供給器15、排出ライン16で構成される。金属タンゲステン供給器13からは、金属タンゲステンが供給される。金属タンゲステンの形状は特に限定されないが、粉末状、粒状、塊状、棒状、板状などの形状が挙げられる。排出ライン16の後段は図示しない真空脱気ポンプ及び無害化装置に接続されている。処理装置10は図示しない温度調整器によって温度制御できる。

40

【0030】

以下、金属タンゲステンの自然酸化膜のクリーニング方法を説明する。金属タンゲステン供給器13から容器12に金属タンゲステン11を供給する。排出ライン16と不活性ガス供給器15を用いて、容器12を複数回ガス置換する。容器12を減圧にして、六フッ

50

化タングステン供給器 14 から六フッ化タングステンを供給し、反応式(7)の進行によって圧力が減少する。容器 12 を所定温度に加熱し、所定時間経過後、排出ライン 16 から、未反応の六フッ化タングステンガス、及び生成した酸フッ化金属をガスとして排気する。なお、不活性ガス供給器 15 から不活性ガスを供給しながら、不活性ガスを同伴させて排出ライン 16 から酸フッ化金属をガスとして排気してもよい。

【0031】

金属タングステン供給器 13 から容器 12 に金属タングステン 11 を供給する方法として、連続的及び間欠的、いずれの供給方式でもよい。金属タングステン供給器 13 の雰囲気は通常は不活性ガスであるが、雰囲気に六フッ化タングステンガスを添加して、金属タングステンを供給する際に六フッ化タングステンガスを同伴させてもよい。供給する方法として、例えば、ホッパーにロータリーバルブ、スクリューフィーダー、テーブルフィーダー、ピンディスチャージャーなどの供給器を接続し、容器 12 に供給する方法を用いることができる。また、ホッパーから容器 12 に直接、自由落下によって供給してもよい。

10

【0032】

該クリーニング方法により、金属タングステンの自然酸化膜を、下地層の金属タングステンを反応させず、且つ反応によって酸素と水を発生させることなく、プラズマレスで 500 未満で除去することができる。

【0033】

このようにして自然酸化膜を除去した金属タングステンに対して、フッ素ガスや三フッ化窒素ガスを供給して、前記の反応式(1-1)、(1-2)の反応により、六フッ化タングステンを得ることができる。自然酸化膜が無いため、反応初期より、金属タングステンとフッ素ガスなどが反応し、F₂ 又は NF₃ の転化率が高くなる。

20

【0034】

(タングステン膜の酸化膜のクリーニング方法)

本発明の酸化膜の処理方法を用いたクリーニング方法の他の実施形態を、図 2 を用いて説明する。図 2 に示すタングステン酸化物膜の処理装置 20 は、チャンバー 21、ステージ 22、六フッ化タングステンガス供給器 23、窒素ガス供給器 24、排出ライン 25 で構成され、ステージ 22 上には、サンプル 26 が設置されている。排出ライン 25 の後段は図示しない真空脱気ポンプ及び無害化装置に接続されている。処理装置 20 は図示しない温度調整器によって温度制御できる。

30

【0035】

サンプル 26 は、金属タングステンを含む膜の上にタングステン酸化物膜を形成したサンプルであり、例えば、シリコンウェハなどの基板に金属タングステンを含む膜が形成され、その上にさらにタングステン酸化物膜が形成されたサンプルが挙げられる。金属タングステンを含む膜には、金属タングステンの膜だけでなく、タングステンと他の金属の合金の膜も含まれる。また、タングステン酸化物膜には、スパッタリング法などにより形成されたタングステン酸化物の膜だけでなく、金属タングステンを含む膜の自然酸化膜も含まれる。

【0036】

以下、サンプル 26 のタングステン酸化物膜のクリーニング方法を説明する。排出ライン 25 と不活性ガス供給器 24 を用いて、チャンバー 21 を複数回、不活性ガスで置換する。チャンバー 21 を減圧にして、六フッ化タングステン供給器 23 から六フッ化タングステンを供給し、反応式(7)の進行によって圧力が減少する。チャンバー 21 を所定温度に加熱し、所定時間経過後、排出ライン 25 から、未反応の六フッ化タングステンガス、及び生成した酸フッ化金属をガスとして排気する。なお、不活性ガス供給器 24 から不活性ガスを供給しながら、排出ライン 25 から不活性ガスに同伴させて酸フッ化金属ガスを排気してもよい。

40

【0037】

該クリーニング方法により、金属タングステンを含む膜の上に形成されたタングステン酸化物膜を、下地層の金属タングステンを反応させず、且つ酸素と水を発生させることなく

50

、プラズマレスで 500 未満で除去することができる。

【0038】

また、本発明のタンゲステン酸化物の処理方法により自然酸化膜を除去した金属タンゲステンに、フッ素ガスまたは三フッ化窒素ガスを供給・反応させることにより、六フッ化タンゲステンを好適に得ることができる。

【実施例】

【0039】

具体的な実施例により、本発明のタンゲステン酸化物の処理方法を説明する。実施例におけるタンゲステン酸化物の処理を評価する実験装置を図3に示す。しかしながら、本発明のタンゲステン酸化物の処理方法は、以下の実施例により限定されるものではない。以下の実施例・比較例では、表面にタンゲステン酸化物を有する金属タンゲステン板を用いて、六フッ化タンゲステンとタンゲステン酸化物又は金属タンゲステンとの反応を評価した。

10

【0040】

【実施例1】

タンゲステン酸化物を除去する処理装置30に関して、Ni製の外径25.4mm、内径22.1mm、長さ300mmの容器32に、ヒーター36が具備され、タンゲステン酸化物を処理するための処理ガス供給器33、装置をガス置換するための窒素ガス供給器34、真空ポンプが後段に設置されている排出ライン35が接続されている。容器32に大気暴露によってタンゲステン酸化物が表面に形成された金属タンゲステン板（厚さ2mm、縦10mm、横10mm）を設置し、排出ライン35で真空脱気、及び窒素ガス供給器34から窒素ガスの供給を複数回実施して、容器32を窒素ガスで置換した。処理ガスで処理する前の金属タンゲステン板の表面をX線光電子分光分析装置（ULVAC-PHI製、PHI 5000 Versa Probe IIシリーズ）で表面を分析した結果、金属タンゲステン（軌道4f7/2、束縛エネルギー31.6eV）に対するタンゲステン酸化物（軌道4f7/2、束縛エネルギー36.1eV）のピーク面積比WO_x/Wは2.5を超えていた。ヒーター36を温度80に加熱して、処理ガス供給器33から六フッ化タンゲステンガスを流量10sccm(0.1atm)における体積流量cm³/min)で60分間流通後、排出ライン35と窒素ガス供給器34を利用して容器32を窒素ガスで置換した。容器32が室温程度まで降温したことを確認して、大気に暴露させないように金属タンゲステン板を取り出して、X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/W=0.9であり、重量変化は±0.1%未満だった。

20

【0041】

【実施例2】

ヒーター36の温度を110にする以外は、実施例1と同様に金属タンゲステン板を処理した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは0.8であり、重量変化は±0.1%未満だった。

30

【0042】

【実施例3】

ヒーター36の温度を180にする以外は、実施例1と同様に金属タンゲステン板を処理した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは0.01未満であり、重量変化は±0.1%未満だった。

40

【0043】

【実施例4】

ヒーター36の温度を200にする以外は、実施例1と同様に金属タンゲステン板を処理した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは0.01未満であり、重量変化は±0.1%未満だった。

【0044】

【比較例1】

処理ガス供給器33から供給する処理ガスを窒素ガスとする以外は、実施例4と同様に金属タンゲステン板を処理した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは

50

2.5を超えており、重量変化は±0.1%未満だった。

【0045】

[比較例2]

処理ガス供給器33から供給する処理ガスを水素ガスとする以外は、実施例4と同様に金属タングステン板を処理した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは2.5を超えており、重量変化は±0.1%未満だった。

【0046】

[比較例3]

ヒーター36の温度を250とし、処理ガス供給器33から供給する処理ガスをフッ素とする以外は、実施例1と同様に金属タングステン板を処理した。処理中、容器の温度が初期の設定温度より上昇した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは<0.01であり、重量は30%減少した。

10

【0047】

[比較例4]

処理ガス供給器33から供給する処理ガスを三フッ化窒素とする以外は、比較例3と同様に金属タングステン板を処理した。処理中、容器の温度が初期の設定温度より上昇した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは<0.01であり、重量は38%減少した。

【0048】

[比較例5]

ヒーター36の温度を25とし、処理ガス供給器33から供給する処理ガスを三フッ化塩素とする以外は、比較例3と同様に金属タングステン板を処理した。処理中、容器の温度が初期の設定温度より上昇した。X線光電子分光分析装置による表面分析ではWO_x/Wは<0.01であり、重量は32%減少した。

20

【0049】

以上の実施例、比較例を以下の表にまとめた。

【0050】

【表2】

実施例・比較例	条件					結果	
	処理ガス	流量 [sccm]	時間 [min]	流通量 [mol]	初期温度 [°C]	表面分析 WO _x /W	W板重量変化 [%]
実施例1	WF6	10	60	0.027	80	0.9	<±0.1
実施例2	WF6	10	60	0.027	110	0.8	<±0.1
実施例3	WF6	10	60	0.027	180	<0.01	<±0.1
実施例4	WF6	10	60	0.027	200	<0.01	<±0.1
比較例1	N2	10	60	0.027	200	>2.5	<±0.1
比較例2	H2	10	60	0.027	200	>2.5	<±0.1
比較例3	F2	10	60	0.027	250	<0.01	-30
比較例4	NF3	10	60	0.027	250	<0.01	-38
比較例5	ClF3	10	60	0.027	25	<0.01	-32

30

【0051】

以上の通り、処理ガスとして、六フッ化タングステンを用いた場合、タングステン酸化物(膜)の下地材である金属タングステンと反応することなく、タングステン酸化物を選択的に除去できた。一方、従来の技術である水素を処理ガスとして用いた場合、六フッ化タングステンでは酸化物を除去できた200では、タングステン酸化物を除去及び還元することはできなかった。また、処理ガスとして、フッ素、三フッ化窒素、及び三フッ化塩素を処理ガスとして用いた場合、タングステン酸化物を除去することはできたが、下地材

40

50

である金属タンゲステンと反応し、タンゲステン酸化物のみを選択的に除去することはできなかった。

【符号の説明】

【0052】

10 処理装置

11 自然酸化膜を有する金属タンゲステン

12 容器

13 金属タンゲステン供給器

14 六フッ化タンゲステン供給器

15 不活性ガス供給器

16 排出ライン

101、102、103、104 仕切弁

20 処理装置

21 チャンバー

22 ステージ

23 六フッ化タンゲステン供給器

24 不活性ガス供給器

25 排出ライン

26 サンプル

201、202、203 仕切弁

30 処理装置

31 自然酸化膜を有する金属タンゲステン板

32 容器

33 処理ガス供給器

34 窒素ガス供給器

35 排出ライン

36 ヒーター

301、302、303 仕切弁

10

20

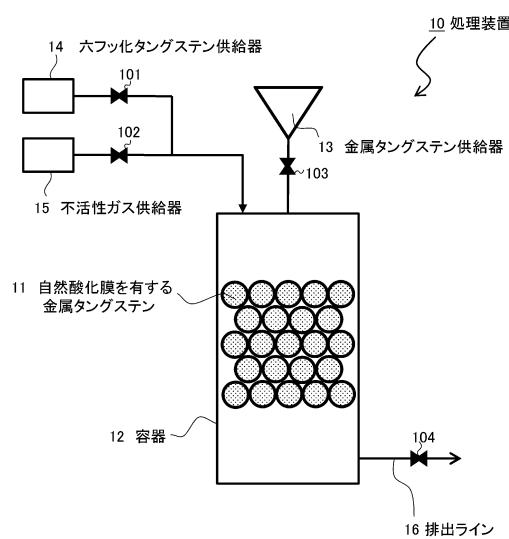
30

40

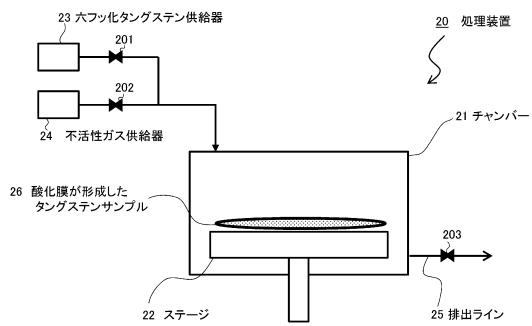
50

【図面】

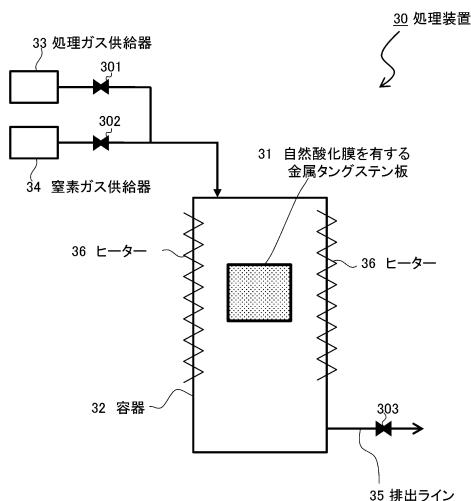
【図 1】



【図 2】



【図 3】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

(72)発明者 菊池 亜紀応

山口県宇部市大字沖宇部 5253番地 セントラル硝子株式会社化学研究所内

審査官 瀧口 博史

(56)参考文献 米国特許第5286520(US, A)

特開平6-299320(JP, A)

(58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)

C23G 5/00

C01G 41/04

C23F 15/00